# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-233262

(43)Date of publication of application : 27.08.1999

(51) Int. Cl.

HO5B 33/22 // CO9K 11/06

(21) Application number: 10-034599

(71) Applicant: KIDO JUNJI

A I MESU: KK

(22) Date of filing:

17. 02. 1998 (72) Inventor:

KIDO JUNJI MIZUKAMI TOKIO

**ENDO JUN** 

# (54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To materialize a low drive voltage despite of a work function of a negative electrode material by setting an organic metal complex compound to a component of an organic layer and by constituting a negative electrode of a metal which can reduce a metal ion contained in the complex compound to a metal under vacuum.

SOLUTION: An organic metal complex compound used for an organic layer contains, at least, one of an alkali metal ion, an alkaline earth metal ion, a rare earth metal ion. Either of Al, Zr, Ti, Y, Sc, and Si is preferable for a metal used for the negative electrode and a single metal or an alloy containing a plurality of types may be contained therein. A metal of the organic metal complex is isolated by using a reducing force of such metals under vacuum and the organic compound is reduced by its free metal so that an electron injection barrier can be miniaturized and consequently the drive voltage can be reduced.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

RECEIVED

MAR 1 4 2002

TC 1700

Copyright (C): 1998, 2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平11-233262

(43)公開日 平成11年(1999)8月27日

(51) Int.CL<sup>6</sup> 類別記号 P I H 0 5 B 33/22 H 0 5 B 33/22 B # C 0 9 K 11/06 6 6 0 C 0 9 K 11/06 6 6 0

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 9 頁)

(21)出顧番号 特顧平10-34599 (71)出顧人 597011728 城戸 淳二 (22)出願日 平成10年(1998) 2月17日 奈良県北葛城郡広陵町馬見北9-4-3 (71)出顧人 593191350 株式会社アイメス 神奈川県藤沢市桐原町3番地 (72)発明者 城戸 淳二 奈良県北葛城郡広陵町馬見北9-4-3 (72)発明者 水上 時雄 神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社ア イメス内 (74)代理人 弁理士 三備 邦夫 最終頁に続く

# (54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセント素子

#### (57)【要約】

【課題】 従来から配線材として一般に用いられてきた 安価で安定な金属を陰極材料として用いることができ、 有機層への電子注入におけるエネルギー障壁が小さく、 駆動電圧が低く、高効率、高輝度の有機エレクトロルミ ネッセント素子を提供すること。

【解決手段】 陰極電極6に接する有機層5をアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも1種をを含有する有機金属錯体化合物から構成し、陰極針科として有機層の構成材料である有機金属錯体化台物中に含まれる金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属を用いた有機エレクトロルミネッセント素子。

	•
6	陰枢電極
5 ——	有機層 (電子注入層)
4	<b>杂光層</b>
3 —	正孔蘭送層
2 ——	陽種透明電極(ITO)
1 —	透明基板

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向する陽極高極と陰極高極の間に位置する少なくとも一層の有機化台物から錯成される発光層と、陰極高極に接する有機層とを有する有機エレクトロルミネッセント素子において、上記有機層がアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも1種を含有する有機金属錯体化合物により構成され、且つ、陰極電極が該錯体化合物中に含有される金属イオンを真空中において金属に逗元しうる金属からなることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項2】 請求項1記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、陰極電極に用いる金属がA1、Zr、Ti、Y、Sc、Siのいずれかである有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項3】 請求項1記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、陰極電極に用いる金属がA1. Zr. Tr. Y、Sc、Srのうち1種以上を含有する合金である有級エレクトロルミネッセント素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】本発明は、平面光源や表示素子に利用される有機エレクトロルミネッセント素子(以下、有機EL素子)に関するものである。

[0002]

【従来の技術およびその問題点】発光層が有機化合物が ら構成される有機に素子は、低電圧駆動の大面積表示素 子を実現するものとして注目されている。Tangらは素子 の高効率化のため、キャリア輸送性の異なる有機化合物 を積層し、正孔と電子がそれぞれ陽極、陰極よりバラン スよく注入される構造とし、しかも有機層の膜厚が2000 A以下とすることで、10V 以下の印加電圧で1000cd/㎡ と外部量子効率1%の実用化に十分な高輝度、高効率を 得ることに成功した(Appl、Phys、Lett., 51, 913 (1 987). )。この高効率素子において、Tangらは基本的に 絶縁物とみなされる有機化合物に対して、金属電極から 電子を注入する際に問題となるエネルギー障壁を低下さ せるため、仕事関数の小さいMg( マグネシウム) を使用 した。その際、Midt酸化しやすく、不安定であるのと、 有機表面への接着性に乏しいので、比較的安定でしかも 40 有機表面に密着性の良いAq( 銀) と共素者により合金化 して用いた。

【0003】凸版EP刷株式会社のグループ(第51回応用物理学会学術譜演会、譜演予橋集28a-P8-4、p.1040) およびパイオニア株式会社のグループ(第54回応用物理学会学術講演会、譜演予稿集29p-ZC-15、p.1127) は、MGより更に仕事関数の小さいに(リチウム)を用いる1(アルミニウム)と合金化する等により安定化させ陰極として用いることにより、MG合金を用いた素子より低い駆動電圧と高い発光輝度を達成している。また、本発50 明者らは有機化合物層上にリチウムを単独で10人程度に 極めて薄く蒸着し、その上から銀を情層した二層型陰極 が低駆動電圧の実現に有効であることを報告している (IEEE Trans. Electron Devices., 40, 1342 (199 3))。

【0004】最近ではUNIAX 社のPei らが、ポリマー発 光層にリチウム塩をドービングし、駆動電圧を低下する 亭に成功している(Scrence, 269, 1086 (1995) )。こ れは電圧印加によってポリマー発光層中に分散したLi塩 を解離させ、陰極と陽極近傍にそれぞれLiイオンと対イ オンを分布させることにより電極近傍のポリマー分子を in situ でドービングするものである。この場合、陰極 近傍のポリマーは電子供与性(ドナー)ドーパントであ るいによって還元されたラジカルアニオン状態で存在す るため、陰極からの電子注入障壁はヒュトーピングしない。 場合より極めて低くなる (Scrence, 269, 1086 (1995) )。さらに、最近では本発明者らはリチウムなどのア ルカリ金屑、ストロンチウムなどのアルカリ土類金属、 サマリウムなどの希土類金属を陰極に接する有機層中に 20 ドービングすることにより、駆動電圧を低下させること に成功した(SID97DIGEST・P775)。こ れは電極に接する有機層を金属ドービングによりラジカ ルアニオン状態とし、陰極からの電子在入障壁を大幅に 低下させたためと考えられる。

【0005】しかしながら、MaやLiの合金電極においても電極の酸化等による素子劣化が起こる上、配牌材料としての機能を考慮しなければならないので、合金電極では電極材料選択において制限を受ける。本発明者らの二層型降極では、Li層の厚みが20人以上では陰極機能しないうえ(IEEE Trans、Electron Devices、40、1342(1993))、極めて滞い10人程度のLiの蒸着は膜厚制御が困難であり素子作製の再現性に問題がある。また、Pen 5の発光層中に塩を添加して電界にて解離させるin situ下ービング法では、解離したイオンの電極近傍までの移動時間が律速となり、素子に答速度が着しく遅くなる欠点がある。有機層を金属でドービング速度が素子特性に影響を及ぼすので、有機層成腹時にドーパント濃度の精密制御が必要である。【00061

40 【発明の目的】本発明は、以上の享信に鑑みてなされたものであり、その目的は簡便かつ確実な方法で陰極から 有機化合物層への電子注入におけるエネルギー障壁を低 下させることにより、陰極材料の仕事関数に関わらず低 駆動電圧を実現することである。 本発明の他の目的 は、A1の様な従来より配牌材として一般に用いられてき た安価で安定な金屑を陰極材料として単独で用いた場合 でも、上述の合金を電極として用いた場合と同様、着し くはそれ以上の特性を発現しうる素子を提供することで ある。

0 [0007]

【発明の概要】すなわち、本発明の有機EL素子は、対 向する陽極電極と陰極電極の間に位置する少なくとも一 層の有機化合物から構成される発光層と、陰極電極に接 する有機層とを有する有機EL素子において、上記有機 層がアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希 土類金属イオンの少なくとも1種を含有する有機金属錯 体化合物を構成要素とするものであって、且つ、陰極電 極が該錯体化合物中に含有される金属イオンを真空中に おいて金属に還元しうる金属からなることを特徴として いる。陰極電極に用いる金属としては、有機層を構成す る有機金属錯体化合物に含まれる金属イオンを真空中で 金属に還元しろる金属であれば、特に制限はないが、例 えば、 A】、Zr. Tí、Y . Sc. Síなどが好ましい。陰極 は、これらの金属単独からなるものであっても、 Al 、 Zr. Ti、Y、Sc. Síなどの金属のうちの一種又は複数種 を含有する合金からなるものであってもよい。上記のよ うな金属及びその合金は、高融点であって、真空中で有 機金属錯体化合物中の金属イオンを金属に還元すること ができる。

【0008】一般にアルカリ金属、アルカリ土類金属、 希土類金属の一部は、高融点金属のAI等に比べ、高い飽 和蒸気圧を示し、酸化、還元反応の起こるような反応温 度において、高融点金属である、A1、51、Zr等でその化 台物を還元できることが知られている。 たとえば、酸化 カルシウムはアルミニウムによって還元され金属カルシ ウムが遊離し(化学便覧。応用化学編1、P369)。酸化 ルビジウム(金属便覧、P88)や酸化ストロンチウム (金属便覧、P89) もアルミニウムによって還元され 金属ルビジウムや金属ストロンチウムが遊離することが 知られている。

【0009】有機EL素子における金属電極の作製は、 10 'torr以下の真空中で行なわれ、 差板上には溶融、 揮発後の原子伏金属が到達する。したがって、アルカリ 金属化合物、アルカリ土類金属化合物、希土類金属化合 物上に、A1、S1、Zr等の熱還元性を有する金層が原子状 で作用すると、前記の例にある真空下での還元反応によ り金属化合物から、金属を還元、遊離させることが可能 である。この時、化合物が有機金属化合物(金属錯体) であれば遊離した金属により自らをドーピング(還元) したり、化合物層が100人以下の薄さであれば、遊離 金属は接触する有機化合物層に作用し、その強い還元性 によって界面付近の有機物を還元する。

【0010】還元されるアルカリ金属化合物、アルカリ 土類金属化合物。希土類金属化合物が酸化物や弗化物等 の無機化合物である場合は、その高い安定性の故に蒸発 温度が高く、有機膜上への蒸若が困難である場合があ る。また、その高い絶縁性のためにその膜厚は著しく制 限を受け、高々20Aが限度である(IEEE Trans, Elec tron Devices, 44, 1245 (1997) ).

のであり、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合 物。希土類金属化合物を無機化合物ではなく有機金属錯 体とすることで蒸発温度を低下させ、しかも良好な成膜 性を得ることができる。また、有機金属錯体は迫当な配 位子を選択することで、電子輸送性やホール輸送性など のキャリア輸送性を付与させることが可能であり、無機 化合物における場合と比較してそれ自体の膜厚の制限を 穏和しうる利点がある。

【0012】本発明は、前記のように、陰極に接する有 機層(電子注入層)をアルカリ金属イオン、アルカリ土 類金属イオン ・ 希土類金属イオンの少なくとも 1 種を含 有する有機金属錯体化合物から構成し、陰極材料として 有機層の構成材料である有機金属錯体化合物に含まれる 金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属を使用し、 このような金属の真空中での還元力を利用して、有機金 **届錯体化合物の金属を遊離させ、さらにその遊離金属で** 有機化合物を還元することにより、電子注入障壁を小さ くし、駆動電圧を低下させることに成功したものであ る。本発明において陰極金属に接する有機層に使用され る有機金属錯体としては、金属イオンとしてアルカリ金 **厚イオン、アルカリ土類金属イオン** 希土類金属イオン の少なくとも一つ含有するものであれば特に限定はな い。また配位子にはキノリノール、ベンジキノリノー ル。アクリジノール、フェナントリジノール、ヒドロキ シフェニルオキサゾール、ヒドロキシフェニルチアゾー ル、ヒドロキンジアリールオキサジアゾール、ヒドロキ シジアリールチアジアゾール、ヒドロキシフェニルビリ ジン、ヒドロキシフェニルベンゾイミダゾール、ヒドロ キシベンゾトリアゾール、ヒドロキシフルボラン、ビビ リジル、フェナントロリン、フタロシアニン、ポルフィ リン、シクロペンタジエン、βージケトン類、アソメチ ン類、およびそれらの誘導体などが好ましいが、これら に限定されるものではない。

[0013]

【発明実施の形態】図1は、本発明による有機EL素子 の一実施形態を示す模式図である。ガラス基板( 透明基 板)1上には、順に、陽極電極を構成する透明電極2、 正孔翰送性を有する正孔翰送層3、発光層4、有機層5 および陰極となる背面電極6を精層してなっている。 こ れらの要素(層)のうち、ガラス基板(透明基板) 1、 透明電極2、正孔輸送層3.および発光層4は周知の要 素であり、有機層5および陰極電極6が本発明で提案し た特徴を有するものである。有機EL素子の具体的な積層 構成としては、この他、陽極/発光層/有機層/陰極、 陽極/正孔翰送層/発光層/有機層/陰極、陽極/正孔 翰送屠/発光屠/電子翰送屠/有機屠/除極、陽極/正 孔注入層/発光層/有機層/陰極、陽極/正孔注入層/ 正孔翰送層/発光層/有機層/陰極、陽極/正孔注入層 /正孔翰送層/発光層/電子翰送層/有機層/陰極、な 【0011】本発明は、以上の享情に鑑みてなされたも 50 どが挙げられるが、本発明による有機EL素子は、有機

層5を陰極電極6の材料の組み合わせが本発明の前期の 条件を満たすのあればいかなる素子構成であっても良い。

【0014】上記有機層5の成膜法は、いかなる薄膜形成法であってもよく、たとえば薬者法やスパッタ法が使用できる。また、溶液からの塗布で薄膜形成が可能な場合には、スピンコーティング法やディップコーティング法などの溶液からの塗布法が使用できる。

【0015】また、上記陰極電極6の成膜法は、蒸岩法 やスパッタ法が使用できるが、真空中における成膜法で 10 あればそれに限定されるものではない。

【りり16】発光層、電子輸送層として使用できる有機 化合物としては、特に限定はないが、p-テルフェニルや クアテルフェニルなどの多環化合物およびそれらの誘導 体。ナフタレン。テトラセン、ピレン。コロネン。クリ セン、アントラセン、ジフェニルアントラセン、ナフタ セン、フェナントレンなどの縮合多環炭化水素化合物及 びそれらの誘導体、フェナントロリン、バソフェナント ロリン、フェナントリジン、アクリジン、キノリン、キ ノキサリン、フェナジンなどの縮合複素環化合物および 20 それらの誘導体や。フルオレセイン、ベリレン、フタロ ペリレン、ナブタロペリレン、ペリフン、フタロペリノ ン。ナフタロベリノン、ジフェニルブタジエン。テトラ フェニルブタジエン、オキサジアゾール、アルダジン、 ビスペングキサゾリン、ビススチリル、ピラジン、シク ロベンタジエン、オキシン、アミノキノリン、イミン、 ジフェニルエチレン、ビニルアントラセン、ジアミノカ ルバゾール、ビラン、チオビラン、ポリメチン。メロシ アニン、キナクリドン、ルブレン等およびそれらの誘導 体などを挙げることができる。また、特別昭63-295695 号公報、特開平8-22557 号公報、特開平8-81472 号公 報、特開平5-9470号公報、特開平5-17764 号公報に開示 されている金属キレート錯体化合物。特に金属キレート 化オキサノイド化合物、例えばトリス(8-キノリノラ ト) アルミニウム、ビス(8-キノリノラト) マグネシウ ム、ビス[ベンゾ(f )-8- キノリノラト]亜鉛、ビス (2-メチル-8- キノリノラト) アルミニウム、トリス (8-キノリノラト) インジウム、トリス(5-メチル-8-キノリノラト) アルミニウム、8-キノリノラトリチウ ム、トリス (5-クロロ-8- キノリノラト) ガリウム、ビ 40 ス(5-クロロ-8- キノリノラト)カルシウムなどの8-キ ノリノラトあるいはその誘導体を配位子として少なくと も一つ有する金属錯体が好道に使用される。

【0017】特開平5-202011号公報、特開平7-179394号公報、特開平7-278124号公報、特開平7-228579号公報に開示されているオキサシアゾール類、特開平7-157473号公報に開示されているトリアシン類、特開平6-203963号公報に開示されているスチルベン誘導体およびシスチリルアリーレン誘導体、特開平6-132080号公報や特開平6-88072号公報に開示されているスチルペン誘導体、特問平6-132080号公報や特開平6-88072号公報に関示されているスチルル・誘導体、4世間・1

6-100857号公報や特開平6-207170号公報に開示されているジオレフィン誘導体も発光層や電子輸送層として好ましい。

【0018】さらに、ベンソオキサゾール系、ベンゾチ アゾール系、ベンゾイミダゾール系などの蛍光増白剤も 使用でき、例えば、特開昭59-194393 号公報に開示され ているものが挙げられる。その代表例としては、2,5-ビ ス(5,7-ジ-t- ベンチル-2-ベンソオキサゾリル)-1,3, 4- チアゾール、4,4'- ビス(5,7-t-ペンチル-2- ベン ゾオキサゾリル)スチルベン、4、4'- ビス[5,7-ジ-(2-メチル-2- ブチル) -2- ベンゾオキサゾリル] スチ ルベン、2,5-ビス(5,7-ジ-t- ペンチル-2- ベンゾオキ サゾリル)チオフェン、2,5-ビス[5-(lpha, lpha– ジメチ ルベンジル)-2-ベンゾオキサゾリル]チオフェン、2,5 -ビス[5,7-ジ- (2-メチル-2- プチル)-2- ベンゾオ キサゾリル]-3,4- ジフェニルチオフェン、2,5-ビス (5-メチル-2- ベンゾオキサゾリル) チオフェン、4,4\* - ビス(2-ベンゾオキサゾリル)ビフェニル、5-メチル -2- (?-[4-(5-メチル-2- ベンゾオキサゾリル)フェ ニル】ビニル】ベンゾオキサゾール、2-[2-(4-クロロ フェニル)ビニル] ナフト(1,2-のオキサゾールなどの ベンゾオキサゾール系、2,2'-(p-フェニレンジビニレ ン)-ビスベンゾチアゾールなどのベンゾチアゾール系、 2-(2-[4-(2-ベンゾイミダゾリル)フェニル)ビニ ル) ベンゾイミダゾール、2-[2-(4-カルボキシフェニ ル)ビニル] ベンゾイミダゾールなどのベンゾイミダゾ ール系などの蛍光増白剤が挙げられる。

[0019] ジスチリルベンゼン系化合物としては、例えば欧州特許第0373582 号明細音に開示されているもののを用いることができる。その代表例としては、1,4-ビス (2-メチルスチリル) ベンゼン、1,4-ビス (4-メチルスチリル) ベンゼン、1,4-ビス (4-メチルスチリル) ベンゼン・1,4-ビス (3-エチルスチリル) ベンゼン・1,4-ビス (3-エチルスチリル) ベンゼン・1,4-ビス (3-エチルスチリル) ベンゼン・1,4-ビス (2-メチルスチリル) -2- メチルベンゼン・1,4-ビス (2-メチルスチリル) -2- エチルベンゼンなどが挙げられる。

【0020】また、特朗平2-252793号公報に開示されているジスチリルビラシン誘導体も発光層、電子輸送層として用いることができる。その代表例としては、2,5-ビス(4-メチルスチリル)ビラジン、2,5-ビス[2-(1-ナフチル)ビニル]ビラジン、2,5-ビス(4-メトキンスチリル)ビラジン、2,5-ビス[2-(4-ビフェニル)ビニル]ピラジンなどが歩けられる。

公報に開示されているトリアジン類。特闘平6-203963号 公報に開示されているスチルベン誘導体およびジスチリ ルアリーレン誘導体、特開平6-132080号公報や特開平6-88072 号公報に開示されているスチリル誘導体、特闘平 50 る。その代表例としては、1,4フェニレンジメチリディ

ン. 4,4'- フェニレンジメチリディン. 2,5-キシリレン ジメチリディン、2、6-ナフチレンジメチリディン、1,4-ビフェニレンジメチリディン、1,4-p-テレフェニレンジ メチリディン、9,10-アントラセンジイルジメチリディ ン. 4,4'- (2,2- ジ-t- プチルフェニルビニル) ビテェ ニル、4,4"-(2,2-ジフェニルピニル) ピフェニル」な ど、及びこれらの誘導体や、特開平6-49079 号公報、特 開平6-293778号公報に開示されているシラナミン誘導 体。特開平6-279322号公報、特開平6-279323号公報に開 示されている多官能スチリル化合物。特別平6-107648号 公報や特閒平6-92947 号公報に開示されているオキサジ アゾール誘導体、特開平6-206865号公報に開示されてい るアントラセン化合物、特開平6-145146号公報に開示さ れているオキシネイト誘導体、特別平4-96990 号公銀に 開示されているテトラフェニルブタジエン化合物。特開 平3-296595号公報に開示されている有機三官能化合物、 さらには、特開平2-191694号公報に開示されているクマ リン誘導体、特別平2-196885号公報に開示されているべ リレン誘導体、特開平2-255789号に開示されているナフ タレン誘導体、特別平2-289676号及び特別平2-88689 号 20 公報に開示されているフタロペリノン誘導体、特開平2-250292号公報に開示されているスチリルアミン誘導体な どが挙げられる。さらに、従来有機EL素子の作製に使用 されている公知のものを適宜用いることができる。 【0022】正孔注入層。正孔輸送層。正孔輸送性発光 特に限定はないが、特開平6-25659 号公報、特開平6-20 3963号公報、特開平6-215874号公報。特開平7-145116号

層として使用されるアリールアミン化合物類としては、 公報:特別平7-224012号公報、特別平7-157473号公報、 特開平8-48656 号公報、特開平7-126226号公報。特開平 7-188130号公報。特開平8-40995 号公報、特開平8-4099 6号公報、特開平8-40997号公報、特開平7-126225号公 報。特別平7-101911号公報、特別平7-97355 号公報に開 示されているアリールアミン化合物類が好ましく。例え ぱ、N,N,N',N'-テトラフェニル-4,4'-ジアミノフェニ ル. N,N'- ジフェニル-N,N'-ジ(3-メチルフェニル)-4,4'-ジアミノビフェニル、2,2-ビス(4-ジ-p- トリル アミノフェニル)プロパン、N,N,N',N'-テトラ-p- トリ ル-4,4'-ジアミノビフェニル、ビス(4-ジ-p- トリルア ミノフェニル) フェニルメタン、N,N'- ジフェニル-N, N'-ジ(4-メトキシフェニル)-4、4'-ジアミノビフェニ ル、N,N,N',N'-テトラフェニル-4,4'-ジアミノジフェニ ルエーテル、4,4'- ピス(ジフェニルアミノ)クオード リフェニル、4-N,N-ジフェニルアミノ- (2-ジフェニル ビニル) ベンゼン、3-メトキシ-4\*-N,N-ジフェニルアミ ノスチルベンゼン、N-フェニルカルパゾール、1,1-ビス (4-ジ-p-トリアミノフェニル) - シクロヘキサン、 1,1-ビス(4ジ-p-トリアミノフェニル)-4- フェニル シクロヘキサン、ビス(4-ジメチルアミノ-2- メチルフ ェニル) - フェニルメタン、N,N,N-トリ (p-トリル) ア 50

ミン、4-(ジ-p- トリルアミノ)-4'- [4 (ジ-p- トリ ルアミノ)スチリル]スチルベン、N,N,N',N'-テトラフ ェニル-4,4'-ジアミノ- ビフェニルN-フェニルカルパゾ ール、4、4'- ビス[N-(1-ナフチル)-N- フェニル- ア ミノ】ビフェニル、4、4\*'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニル- アミノ] p-ターフェニル、4,4'- ビス [N-(2-ナフチル)-N- フェニル- アミノ] ビフェニル、4、 4'- ビス [N- (3-アセナフテニル) -N- フェニル- アミ ノ〕ビフェニル.1,5-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェ ニル- アミノ] ナフタレン、4,4'- ビス [N- (9-アント リル)-N- フェニル- アミノ] ピフェニル、4,411-ピス [N-(1-アントリル)-N- フェニル- アミノ] p-ターフ ェニル、4,4'- ビス[N-(2-フェナントリル)-N- フェ エル- アミノ] ピフェエル、4,4'- ピス [N- (8-ブルオ ランテニル)-N- フェニル- アミノ] ビフェニル、4,41 - ビス [N- (2-ビレニル) -N- フェニル- アミノ] ビフ ェニル、4,4'- ビス[N-(2-ペリレニル)-N- フェニル - アミノ] ビフェニル、4,4'-ビス [N-(1-コロネニ ル) -N- フェニル- アミノ] ビフェニル、2,6-ビス (ジ -p- トリルアミノ) ナフタレン、2,6-ビス [ジ- (1-ナ フチル) アミノ] ナフタレン、2,6-ビス [N- (1-ナフチ ル) -N- (2-ナフチル)アミノ] ナフタレン、4.4''-ビ ス [ N,N=ジ(2-ナフチル)アミノ ] ターフェエル、4、41 - ビス {N-フェニル-N- 〔4-(1-ナフチル)フェニル〕 アミノ} ピフェニル、4,41- ピス[N-フェニル-N- (2-ピレニル)- アミノ] ビフェニル、2,6-ビス [N,N-ジ (2-ナフチル) アミノ] フルオレン、4,4''- ビス (N. N-ジ-p- トリルアミノ)ターフェニル、ビス(N-1-ナフ

[0023] さらに、正孔注入層、正孔輸送層。正孔輸送性発光層として、上述の有機化合物をポリマー中に分散したものや。ポリマー化したものも使用できる。ポリパラフェニレンビニレンやその誘導体などのいわゆる π 共役ポリマー。ポリ(トビニルカルパゾール) に代表されるホール輸送性非共役ポリマー、ポリシラン類のシグマ共役ポリマーも用いることができる。

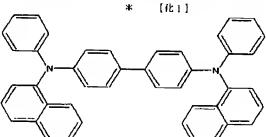
チル)(N-2-ナフチル)アミンなどがある。 さらに、従

来有機EL素子の作製に使用されている公知のものを適宜

用いることができる

【0024】ITO 電極上に形成する正孔注入層として は、特に限定はないが、銅フタロシアニンなどの金属フタロシアニン類に カーボン膜、ボリアニリンなどの導電性ボリマーが好道に使用できる。さらに、前述のアリールアミン類に酸化剤としてルイス酸を作用させ、ラジカルカチオンを形成させて正孔注入層として用いることもできる。

評価には、ケースレー社ソースメータ2400、トプコンBM -8輝度計を使用した。素子のITO を陽極、Alを陰極とし て直流電圧を10/2秒の割合でステップ状に印加し、 電圧上昇1 秒後の輝度および電流値を測定した。また、 ELスペクトルは浜松ホトニクスPMA-10オプチカルマルチ チャンネルアナライザーを使用して定電流駆動し測定し た.



で表わされるαNPD を10° torr下で、2 A/秒の蒸着速 度で500 Aの厚さに成膜し、正孔輸送層3を形成した。

緑色発光を有する下記式:

[12]

で表されるトリス(8- キノリノラト) アルミニウム錯 体層(以下「A1g 」という)4を正孔輸送層3と同じ条 件で700 Aの厚さに真空蒸着して形成した。次に、前期 発光層4の上に、有機層(電子注入層)5 として下記 式:

[ft3]

で表わされるモノ(8- キノリノラト) リチウム錯体 層(以下「Liq 」という)5 を10° torr下で、1 A/秒 の蒸着速度で10Aの厚さに成膜した。最後に、前記有機 層(電子注入層)5の上に、陰極となる背面電極6とし

\*【0026】実施例1

図1の積層構成の有機EL素子に本発明を適用したもので ある。ガラス芸板1上に陽極透明電極2として、シート 抵抗25♀/□のITO ( インジウム- スス酸化物、三容真 空社製スパッタ蒸着品) がコートされている。その上に 正孔翰送性を有する下記式:

縦0.5cm 、横0.5cm の正方形状とした。前記の有機EL素 子において、陽極電極であるITO と陰極電極であるA16 次に、前記正孔輸送層3の上に、発光層4として 20 との間に、直流電流を印加し、発光層Alq 4から緑色 発光の輝度を測定した。図2、図3中の丸ブロットは輝 度- 電圧特性、輝度 - 電流密度特性を示すもので、最高 27、000cd/m の高輝度を14V において示した。このとき の電流密度は333mA/cm であった。また1,000cd/m の輝 度は8.5Vで得られた。

【0027】比較例1

実施例1と同じく、ITO 上にまず正孔輸送層として@NP D を500 Aの厚さに成膜し、その上に、発光層としてAl q を正孔輸送層と同じ条件で700 Aの厚さに真空蒸若し て形成した。そして、Alg の上から陰極としてAlを1,00 の輝度- 電圧特性、輝度- 電流密度特性を示すものであ り、16V で最高1,600cd/m の輝度をしか与えなかった。 また1,000cd/m の輝度を得るのに14.5V ED加する必要が あった。この実験から駆動電圧を下げるのに有機層(電 子注入層)5が有効であることがわかる。

【りり28】実施例2

ITO上に、正孔輸送層3として《NPD を500 A. 発光層 4 としてAlg を700 Aの厚さに真空蒸着した後下記式: [124]

で示されるモノ(8 - キノリノラト)ナトリウム錯体( 以下「Nag 」という)を有機層(電子注入層)5 として 10-6torr下で、1 A/紗の蒸着速度で10Aの厚さに成膜 てAI を蒸着速度10A /秒で1000 A 蒸着した。発光領域は 50 した。その上から、陰極電極 6 としてAI を 1000 A 蒸着し

1

素子を作製した。この素子は印加電圧13V で最高輝度3 1,500cd/m と電視密度319mA/cm を与え、実施例1と 同じく、低い駆動電圧で高輝度を与えた。

[0029] 実施例3

ITO 上に、正孔翰送層3として α NPO を500 A. 発光層 4 としてAlq を700 Aの厚さに真空蒸着した後下記式: 【化5】

で示されるモノ(2, 2, 6, 6- テトラメチル-3, 5- ヘプタンジオナト)リチウム錯体(以下「L1(dpm))」という)を有機層(電子注入層)5 として10° torでで、1 A/秒の蒸若速度で10Aの厚さに成膜した。その上から、陰極電極6としてAIを1000A蒸若し素子を作設した。この素子は印加電圧15Vで最高超度18,000cd 20 ㎡ と電流密度327mA/cm を与え、実施例1と同じく、低い駆動電圧で高超度を与えた。

【0030】実施例4

ITO 上に、正孔翰送層3として a NPO を500 点。発光層 4としてAlq を700 点の厚さに真空蒸着した後下記式: 【化6】

で示されるモノ (2, 2、6,6-デトラメチル-3、5-ヘプタンジオナト)ナトリウム錯体(以下「Na(dpm)」という)を有機層(電子注入層)5として10でtor下で、1 A / 秒の蒸着速度で10A の厚さに成膜した。その上から、陰極電極6としてAIを1000A 蒸着し素子を作製した。この素子は印加電圧14Vで最高輝度21,000cd/m と電流密度43 anA/cm を与え、実施例1と同じ 40く、低い駆動電圧で高輝度を与えた。

【りり31】実施例5

ITO 上に、正孔輸送層3としてαNPO を500 Å. 発光層 4としてAlq を700 Åの厚さに真空蒸着した後下記式: 【化?】 (7)

で示されるモノ(2,2、6,6-テトラメチル-3,5-ヘブタンジオナト)ルビジウム錯体(以下「Rb(dp 10 m)」という)を有機層(電子注入層)5として10 to rr下で、1A/秒の蒸若速度で10Aの厚さに成職した。その上から、陰極電極6としてAIを1000A蒸若し素子を作製した。この素子はEP加電圧13Vで最高輝度25,000cd/m²と電流密度504mA/cm²を与え、実施例1と同じく、低い駆動電圧で高輝度を与えた。

【0032】実施例6

ITO 上に、正孔輸送層3としてαNPO を500 Å、発光層4としてAlq を700 Åの厚きに真空蒸着した後下記式: [化8]

で示されるシ(2,2,6、6、6-テトラメチル-3,5-ヘプタンジオナト)マグネシウム錯体(以下「Mg(dp 30 m)2」という)を有機層(電子注入層)5として10°torでで、1人/秒の蒸着速度で10人の厚さに成験した。その上から、陰極電極6としてAIを1000A蒸着し素子を作製した。この素子はED加電圧17Vで最高輝度3,400cd/㎡と電流密度120mA/cm²を与え、実施例1と同じく、低い駆動電圧で高輝度を与えた。

[0033]実施例7

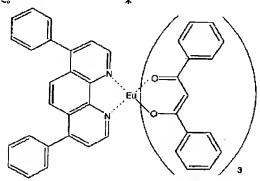
ITO 上に、正孔翰送層3として a NPO を500 点。発光層4としてAlq を700 点の厚さに真空蒸着した後下記式: 【化9】

で示されるジ(2,2,6,6- テトラメチル- 3,5 - ヘプタンジオナト)カルシウム錯体(以下「Ca(clom) 50 2」という)を有機層(電子注入層)5として10° torr 13

下で、1A/秒の蒸着速度で10Aの厚さに成膜した。その上から、陰極電極6としてAIを1000A蒸着し素子を作製した。この素子はED加電圧18Vで最高超度14,300cd/m と電流密度168mA/cm を与え、実施例1と同じく、低い駆動電圧で高超度を与えた。

\* 【0034】実施例8 ITO上に、正孔翰送層3としてe/NPOを500 A. 発光層4としてAlgを700 Aの原文に自物状態にかれて記載した後で記載する

4 としてAlq を700 Aの厚さに真空蒸着した後下記式: 【化 1 0 】



で示されるトリ(1,3-フェニル-1,3-プロパンジオナト)モノ(パソフェナントロリン)ユウロビウム錯体(以下「Eu(clom)3・Bphen」という)を有機層(電子注入層)5として10°でtorr下で、1人/秒の蒸着速度で10人の厚さに成験した。その上から、陰極電極6としてA1を1000人蒸着し素子を作製した。この素子は印加電圧13Vで最高輝度12,000cd/㎡と電流密度230mA/c㎡を与え、実施例1と同じく、低い駆動電圧で高輝度を与えた。

#### [0035]

【発明の効果】本発明は、陰極に接する有機層をアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも1種を含有する金属錯体化合物から構成し、有機層の構成材料である金属錯体化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属を陰極材料として使用することによって、従来から配線材として一般に用いられてきた安価で安定な金属を陰極材料として用いることができ、しかも電子注入陰壁を小さく ※

で示されるトリ(1,3 – フェニル– 1,3 – プロパン ※ し、駆動電圧が低く、高効率、高輝度の有機EL素子のジオナト)モノ(バソフェナントロリン)ユウロビウム 20 作製を可能にしたものである。したがって、本発明の有錯体(以下「Eu(clom)3 - Bphen 」という)を有機層(電 機EL素子は実用性が高く、表示素子や光線としての有子注入層)5 として10° torr下で、1A/秒の蒸着速度 効利用が期待できる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機Eし素子の行屠構造例を示す模式 ・ 断面図である。

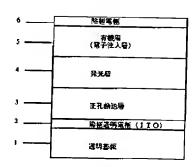
【図2】本発明の有機EL素子と比較例の輝度-電圧特性を示すグラフ図である。

【図3】本発明の有機EL素子と比較例の輝度 – 電流密度特性を示すグラフ図である。

#### 【符号の説明】

- 1 透明基板
- 2 陽極透明基板
- 3 正孔翰送層
- 4 発光層
- 5 有機層
- 6 陰極電極

[図]]



フロントページの続き

(72)発明者 遠藤 湖 神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社ア イメス内